

证书号第 4766654 号



发明专利证书

发明名称：一种 InGaN 半导体材料及其外延制备方法和应用

发明人：江灏;王海龙

专利号：ZL 2019 1 0667348.9

专利申请日：2019 年 07 月 23 日

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市海珠区新港西路 135 号

授权公告日：2021 年 11 月 02 日

授权公告号：CN 110610849 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号 第 4766654 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中山大学

发明人：

江灏;王海龙

证书号第 5062034 号



发明专利证书

发明名称：一种 n 型 AlGa_N 半导体材料及其外延制备方法

发明人：江灏;温泉;吕泽升;邱新嘉

专利号：ZL 2019 1 0759343.9

专利申请日：2019 年 08 月 16 日

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市海珠区新港西路 135 号

授权公告日：2022 年 04 月 08 日

授权公告号：CN 110611003 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号 第 5062034 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 16 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中山大学

发明人：

江灏；温泉；吕泽升；邱新嘉

证书号第 5643994 号



发明专利证书

发明名称：一种制备 InGa_N 外延层的方法

发明人：江灏;吕泽升

专利号：ZL 2021 1 0496037.8

专利申请日：2021 年 05 月 07 日

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市海珠区新港西路 135 号

授权公告日：2022 年 12 月 13 日

授权公告号：CN 113493927 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号 第 5643994 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 07 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中山大学

发明人：

江灏；吕泽升

证书号第7907361号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种低阻高反射欧姆接触电极及其制备方法

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市海珠区新港西路135号

发明人：江灏;孙悦;卢家冰;吕泽升

专利号：ZL 2022 1 0267283.0

授权公告号：CN 114725263 B

专利申请日：2022年03月17日

授权公告日：2025年04月29日

申请日时申请人：中山大学

申请日时发明人：江灏;孙悦;卢家冰;吕泽升

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

